

**Europäisches Patentamt** 

European Pat nt Office

Office europé n des brevets



(11) EP 0 892 485 A3

(12)

#### **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(88) Veröffentlichungstag A3: 18.10.2000 Patentblatt 2000/42

(51) Int. CI.7: **H02M 3/28**, H02M 3/335

(43) Veröffentlichungstag A2: 20.01.1999 Patentblatt 1999/03

(21) Anmeldenummer: 98111061.2

(22) Anmeldetag: 17.06.1998

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU

MC NL PT SE

Benannte Erstreckungsstaaten:

AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 15.07.1997 DE 19730243

(71) Anmelder: ABB PATENT GmbH 68309 Mannheim (DE)

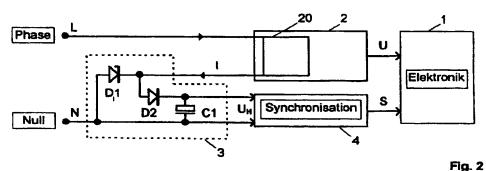
(72) Erfinder: Heite, Christian, Dr. 58553 Halver (DE)

(74) Vertreter:
Rupprecht, Klaus, Dipl.-Ing. et al c/o ABB Patent GmbH,
Postfach 10 03 51
68128 Mannheim (DE)

#### (54) Stromversorgungseinrichtung

(57) Die Erfindung bezieht sich auf eine Stromversorgungseinrichtung mit einer Haupt-Stromversorgungseinheit (2) und einer Hilfs-Stromversorgungseinheit (3) zur Erzeugung einer Hilfsspannung (U<sub>H</sub>). Zur Verringerung des Schaltungsaufwands sowie der Verlustleistung für die Hilfsspannungserzeugung wird vorgeschlagen, die beiden Stromversorgungseinheiten elektrisch in Reihe zu schalten. Die Hilfsstromversorgungseinheit (3) kann vorteilhaft realisiert werden

mit Hilfe einer vom Primärstrom (I) durchflossenen Zenerdiode (D1), der eine Reihenschaltung einer Gleichrichterdiode (D2) und eines Kondensators (C1) parallelgeschaltet ist, wobei die erzeugte Hilfsspannung am Kondensator (C1) abgreifbar ist. Die Stromversorgungseinrichtung läßt sich beispielsweise in Schaltnetzteilen und Dimmern anwenden.





### **EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT**

Nummer der Anmeldung

EP 98 11 1061

	EINSCHLÄGIGI					
Categorie	Kennzeichnung des Dokur der maßgeblich	zeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile			KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.5)	
X	US 5 621 623 A (KUF 15. April 1997 (199 * Spalte 4, Zeile 5 * Spalte 5, Zeile 2 * Abbildungen 2,4 4	77-04-15) 69 - Zeile 63 * 21 - Zeile 24 *	ET AL)	1	H02M3/28 H02M3/335	
A	US 5 485 076 A (SCH 16. Januar 1996 (19 * Spalte 2, Zeile 2 * Spalte 3, Zeile 1 * Spalte 3, Zeile 4 * Abbildungen 2,4	96-01-16) 26 - Zeile 31 * 22 - Zeile 15 * 24 - Zeile 49 *	ET AL)	1-5		
					RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (INLCLE) HO2M	
Der vo	rliegende Recherchenbericht wu	rde für alle Paterriansprüci	ne erstellt			
	Partnershanori MÜNCHEN	Absolvin Bestum der		Dod -	Prüfer	
X : von Y : von ande A : tech O : nich	ATEGORIE DER GENANNTEN DOK besonderer Bedeutung allein betrach besonderer Bedeutung in Verbindung ren Veröffentlichung derseiben Kalen nologischer Hintergrund tschriftliche Offenberung ichenliteratur	tet E: Si ru mit etner D: In porte L: au 8: M	er Erfindung zugr teres Patentdolo teres Patentdolo der Anmeldung is anderen Gründ	unde liegende T ment, das jedoc edatum veröffent angeführtes Doi den angeführtes	licht worden ist ument	

# ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.

EP 98 11 1061

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentiokumente angegeben. Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am Diese Angaben dienen nur zur Untertichtung und erfolgen ohne Gewähr.

23-08-2000

	lm angefü	Recherchenberl hries Palentdok	cht ument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied( Patents	er) der umtile	Datum der Veröffentlichung
	US	5621623	Α	15-04-1997	JP 725	5170 A	03-10-1995
	US	5485076	A	16-01-1996	KEINE	/>	
						4 : <del></del>	
1							
ı							
	1						
ļ							
İ							
ļ							
_							
N Poks							
EPO PORM POAS1							
"							

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr. 12/82

## **EUROPEAN PATENT OFFICE**



01P03883



**PUBLICATION NUMBER** 

2000150875

**PUBLICATION DATE** 

30-05-00

APPLICATION DATE

13-11-98

APPLICATION NUMBER

10323330

APPLICANT: TOSHIBA CORP;

INVENTOR: HACHIMAN AKIHIRO;

INT.CL.

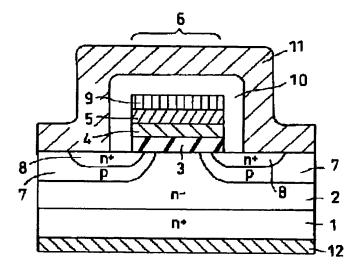
: H01L 29/78 C23C 14/34 C23C 16/34

H01L 21/31 H01L 21/314 H01L 21/336

TITLE

SEMICONDUCTOR DEVICE AND

FORMATION OF THIN FILM



ABSTRACT: PROBLEM TO BE SOLVED: To materialize the material characteristics of SiC and obtain an SiC- FET which can operate stably by preventing the degradation of quality and breakage due to voltage applied to a gate insulation film and reducing leakage current.

> SOLUTION: This device is provided with a first conductive type high resistance drift layer 2 formed on a silicon carbide substrate, a second conductive type base area 7, a first conductive type source area 8, an AIN film 3 formed on the gate area, etc., on the surface of the second conductive type base area, and a surface covering film 4 formed on the AIN film 3. The surface covering film 4 is made of AlxGa1-x-ylny (x: real number, 0≤x≤1; y: real number,  $0 \le y \le 1$ ;  $x+y \le 1$ ), etc.

COPYRIGHT: (C)2000,JPO